(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2004 年4 月8 日 (08.04.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/030062 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/304, C09K 3/14

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/012258

(22) 国際出願日: 2003 年9 月25 日 (25.09.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-279193 2002 年9 月25 日 (25.09.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): セイミケミカル株式会社 (SEIMI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒253-8585 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎三丁目２番１０号 Kanagawa (JP). 旭硝子株式会社 (ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒100-8405 東京都 千代田区 有楽町一丁目１２番１号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 神谷 広幸 (KAMIYA,Hiroyuki) [JP/JP]; 〒221-8755 神奈川県 横浜市 神奈川区羽沢町１１５０番地 旭硝子株式会社内 Kanagawa (JP). 次田 克幸 (TSUGITA,Katsuyuki) [JP/JP]; 〒253-8585 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎三丁目２番１０号 セイミケミカル株式会社内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 泉名 謙治, 外 (SENMYO,Kenji et al.); 〒101-0042 東京都 千代田区 神田東松下町３８番地 鳥本鋼業ビル Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) **Title:** POLISHING COMPOUND COMPOSITION, METHOD FOR PRODUCING SAME AND POLISHING METHOD

(54) **発明の名称:** 研磨剤組成物、その製造方法及び研磨方法

(57) **Abstract:** A polishing compound composition for chemical mechanical polishing of a substrate contains (A) an abrasive grain, (B) an aqueous medium, (C) a tartaric acid, (D) trishydroxymethylaminomethane, and (E) one selected from the group consisting of malonic acids and maleic acids. Preferably, for preventing dishing of a wiring metal portion, the polishing compound composition further contains such a compound as benzotriazole that has a function to form a protective film over the surface of the wiring metal.

(57) 要約:

基板を研磨するための化学的機械的研磨用研磨材であって、（Ａ）砥粒、（Ｂ）水系媒体、（Ｃ）酒石酸、（Ｄ）トリスヒドロキシメチルアミノメタン及び（Ｅ）マロン酸及びマレイン酸からなる群から選ばれる１種以上、を含有し、より好ましくは配線金属部のディッシングを防止するために配線金属表面に保護膜を形成する機能を有するベンゾトリアゾール等の化合物をさらに含有する研磨剤組成物。

WO 2004/030062 A1